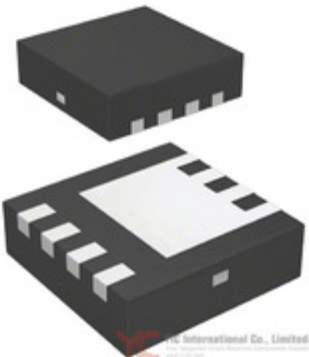

	<h2 style="color: #D9534F;">SISS70DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS70DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 125V
	Datenblätter:  SISS70DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

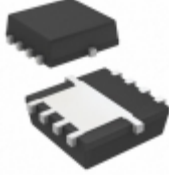




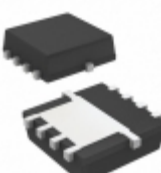

Spezifikationen

Teilenummer	SISS70DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 125V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29.8 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	5.1W (Ta), 65.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S
Andere Namen	SISS70DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	535pF @ 62.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	125V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 125V 8.5A (Ta), 31A (Tc) 5.1W (Ta), 65.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A (Ta), 31A (Tc)

SISS70DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS70DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS70DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS98DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 14.1A 1212-8</p>	 <p>SISS62DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS67DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISS71DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>
 <p>SISS72DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V</p>	 <p>SISS64DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 30V 40A 1212-8S</p>	 <p>SISS65DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS71DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 23A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS70DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS70DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS70DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS70DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS70DN-T1-GE3
SISS70DN-T1-GE3 Electronic	SISS70DN-T1-GE3-Komponenten	SISS70DN-T1-GE3-Verteiler	SISS70DN-T1-GE3-Bild	SISS70DN-T1-GE3-Teil
SISS70DN-T1-GE3 Preis	SISS70DN-T1-GE3 Hersteller	SISS70DN-T1-GE3 Bild	SISS70DN-T1-GE3 Aktie	SISS70DN-T1-GE3 Inventar
SISS70DN-T1-GE3 Neu	SISS70DN-T1-GE3 Original	SISS70DN-T1-GE3 garantiert	SISS70DN-T1-GE3 RFQ	SISS70DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited